

2SC645

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ型/Si NPN Epitaxial Planar

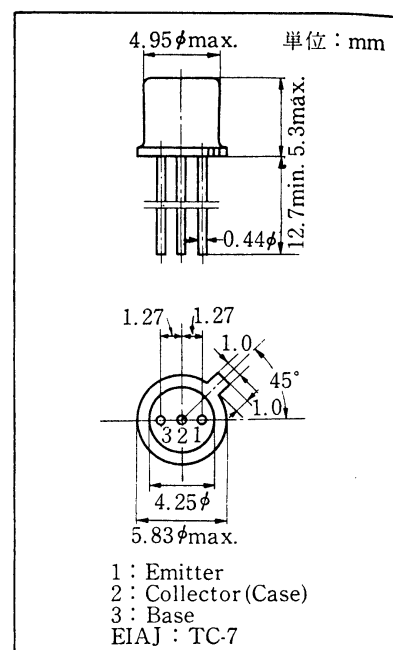
高周波増幅用/RF Amplifier

特 徴

- FM/AMラジオの RF 増幅, 発振, 混合, IF に最適です。
- 帰還インピーダンス $|Z_{rb}|$ が小さい。

最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	20	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	30	mA
コレクタ損失	P_C	140	mW
接合部温度	T_j	175	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+175	°C



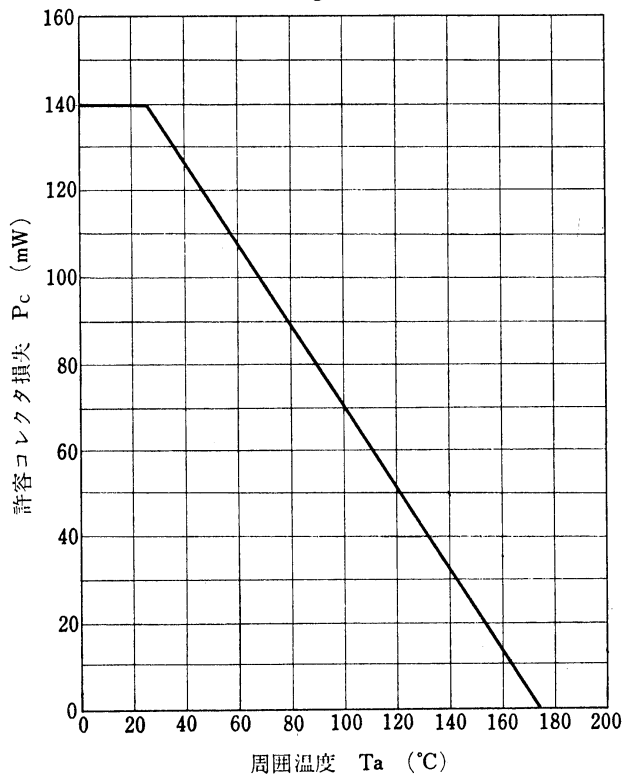
電氣的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

項 目	記 号	条 件	min.	typ.	max.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=10V, I_E=0$			1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CB}=10V, I_C=1mA$	40		250	
小信号電流増幅率	h_{fe}	$V_{CE}=10V, -I_E=1mA$	40		250	
トランジション周波数	f_T	$V_{CB}=10V, I_C=1mA$	150	200		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10mA, I_B=1mA$		0.1		V
コレクタ帰還容量	$-C_{re}$	$V_{CB}=10V, -I_E=1mA$		0.65	1.2	pF
帰還インピーダンス	$ Z_{rb} $	$V_{CB}=10V, -I_E=1mA$		22	50	Ω

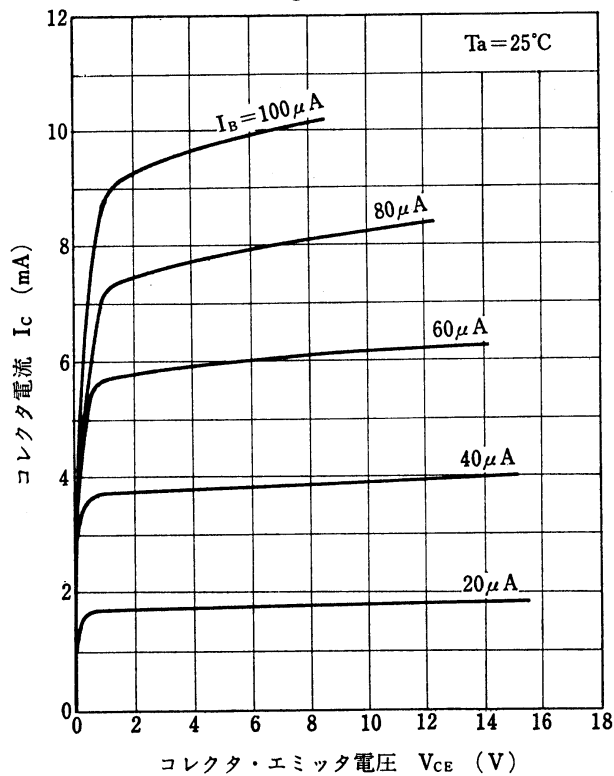
h_{FE} により下表のように分類し, 現品表示しています。

h_{FE}	40~100	70~160	110~250
分類	A	C	B

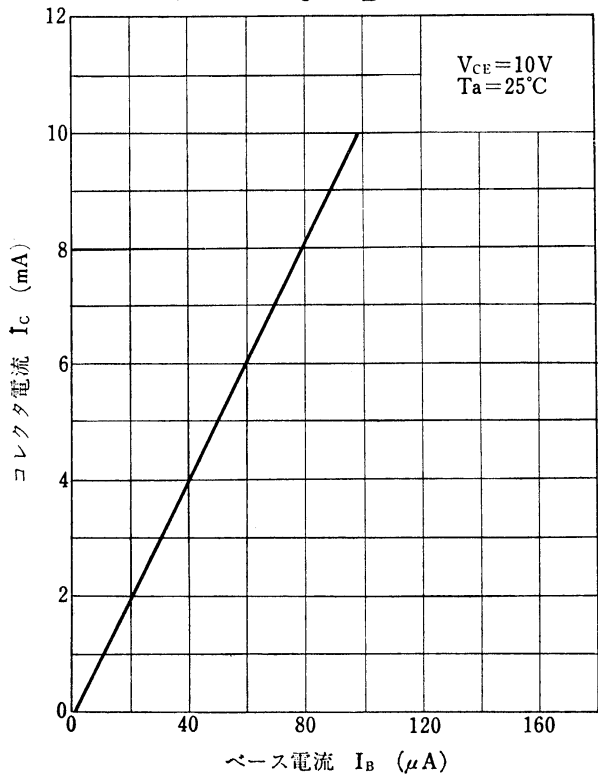
$P_C - T_a$



$I_C - V_{CE}$



$I_C - I_B$



$I_B - V_{BE}$

